
2SB649, 2SB649A

シリコン PNP エピタキシャル形

HITACHI

特長

- 低周波電力増幅用
- 2SD669/A とコンプリメンタリペア

外観図

TO-126 MOD



1. Emitter
2. Collector
3. Base

絶対最大定格

(Ta = 25°C)

項目	記号	2SB649	2SB649A	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-180	-180	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-120	-160	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	-5	V
コレクタ電流	I_C	-1.5	-1.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	-3	-3	A
許容コレクタ損失	P_C	1	1	W
許容コレクタ損失	P_C^{*1}	20	20	W
接合部温度	T_j	150	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	-55~+150	°C

【注】 1. $T_C = 25^\circ\text{C}$ における許容値

電気的特性

(Ta = 25°C)

項目	記号	2SB649			2SB649A			単位	測定条件
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	-180	—	—	-180	—	—	V	$I_C = -1\text{mA}, I_E = 0$
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	-120	—	—	-160	—	—	V	$I_C = -10\text{mA}, R_{BE} = \infty$
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	-5	—	—	-5	—	—	V	$I_E = -1\text{mA}, I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	-10	—	—	-10	μA	$V_{CB} = -160\text{V}, I_E = 0$
直流電流増幅率	h_{FE1}^{*1}	60	—	320	60	—	200		$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -150\text{mA}$
直流電流増幅率	h_{FE2}	30	—	—	30	—	—		$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -500\text{mA}^{*2}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	-1	—	—	-1	V	$I_C = -500\text{mA}, I_B = -50\text{mA}$
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	—	—	-1.5	—	—	-1.5	V	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -150\text{mA}$
利得帯域幅積	f_T	—	140	—	—	140	—	MHz	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -150\text{mA}$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	27	—	—	27	—	pF	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$

【注】 1. 2SB649, 2SB649A は h_{FE1} の値により下記のように区分し、現品に表示してあります。

	B	C	D
2SB649	60~120	100~200	160~320
2SB649A	60~120	100~200	—

2. パルス測定





